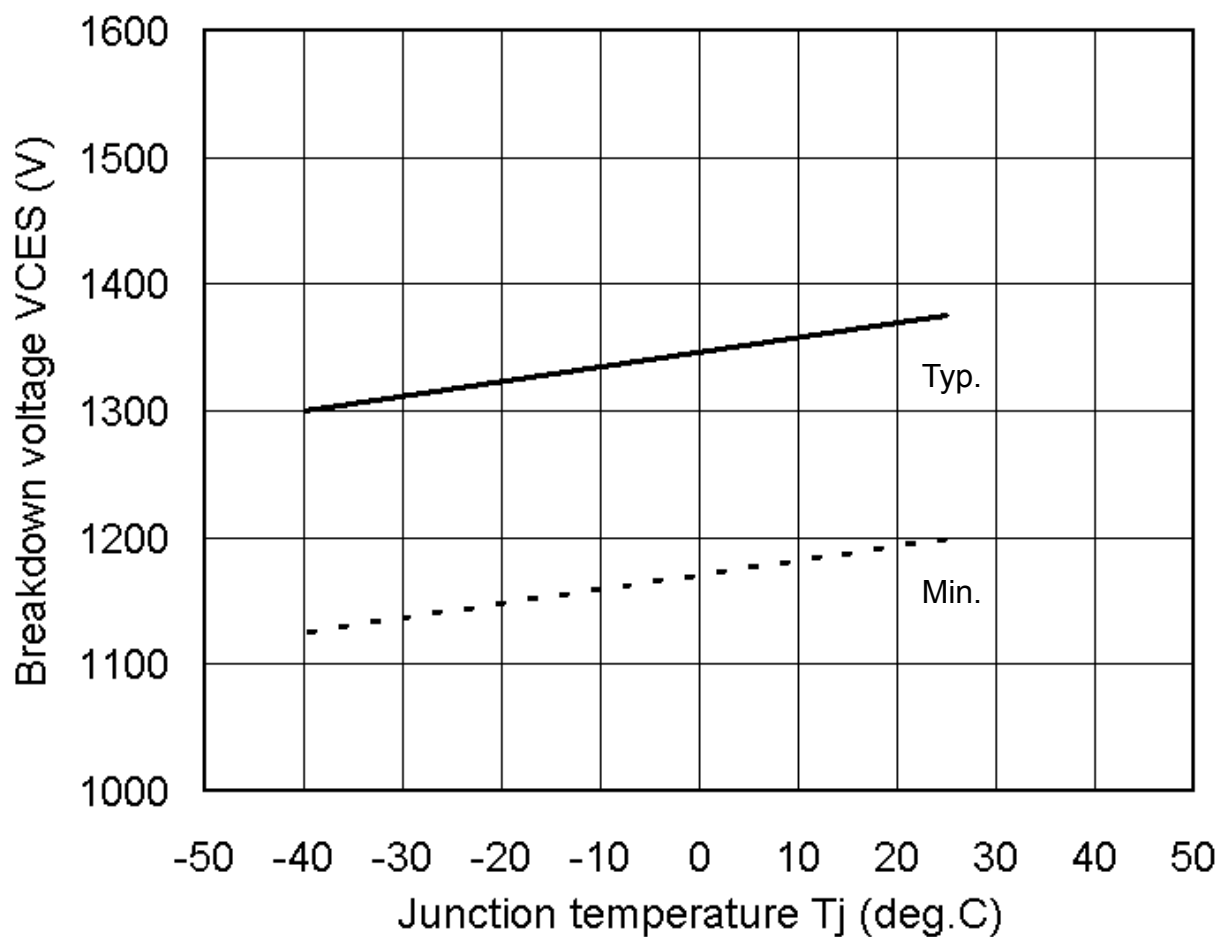


— 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1200V 系列 —

接合耐圧 VCES と接合温度 Tj



接合耐圧の接合温度依存性

一般的に半導体素子は、低温になるに従ってシリコン結晶内の格子振動が低下しキャリアの衝突が抑制されます。これによりインパクトイオン化率が高くなるため、素子耐圧が低くなります。したがって低温での使用が想定される状況におきましては、その耐圧低下を含めた設計をお願いいたします。

技術資料 : MT5F24327